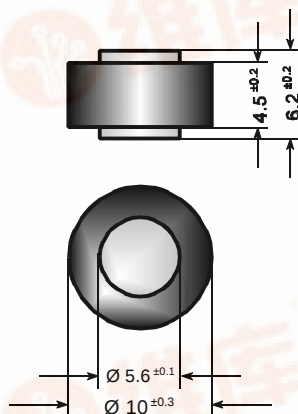


 **Diotec**
RA 2505 ... RA 2510

Silicon Rectifier Button-Cells

Si-Gleichrichterzellen in Button-Bauform



Dimensions / Maße in mm

Nominal current – Nennstrom 25 A

Repetitive peak reverse voltage 50...1000 V

Periodische Spitzensperrspannung

Plastic case, Ø 10 x 6.2 [mm]

coloured metal ring indicates cathode

Kunststoffgehäuse,

Kathode am farbig markierten Metallring

Weight approx. – Gewicht ca. 1.9 g

Plastic material has UL classification 94V-0

Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert

Standard packaging: bulk

Standard Lieferform: Schüttgut

Maximum ratings

Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung. V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
RA 2505	50	80
RA 251	100	130
RA 252	200	250
RA 253	300	350
RA 254	400	450
RA 255	500	550
RA 256	600	650
RA 258	800	850
RA 2510	1000	1050

Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschtung mit R-Last

$T_T = 100^\circ\text{C}$

I_{FAV}

25 A ¹⁾

Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom

$f > 15\text{ Hz}$

I_{FRM}

60 A ¹⁾

Rating for fusing, $t < 10\text{ ms}$
Grenzlastintegral, $t < 10\text{ ms}$

$T_A = 25^\circ\text{C}$

i^2t

1250 A²s

¹⁾ Valid if the temperature of the terminals is kept to 100°C

Gültig, wenn die Temperatur der Kontaktflächen auf 100°C gehalten wird



Peak forward surge current, single half sine-wave, superimposed on rated load Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen, überlagert bei Nennlast	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	500 A
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	$-50\dots+150^\circ\text{C}$
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_s	$-50\dots+175^\circ\text{C}$

Characteristics**Kennwerte**

Forward voltage – Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 25\text{ A}$	V_F	$< 0.95\text{ V}$
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{\text{RRM}}$	I_R	$< 10\text{ }\mu\text{A}$